

**Translation of Priority Certificate**

**JAPAN PATENT OFFICE**

**This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.**

**Date of Application:**

**January 27, 2003**

**Application Number:**

**Patent Application**

**No. 2003-017454**

**[ST.10/C]:**

**[JP2003-017454]**

**Applicant(s):**

**SANYO ELECTRIC CO., LTD.**

**May 9, 2003**

**Commissioner, Japan Patent Office  
Shinichiro Ota**

**Priority Certificate No. 2003-3033564**

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2003年 1月27日

出 願 番 号

Application Number:

特願2003-017454

[ ST.10/C ]:

[ JP2003-017454 ]

出 願 人

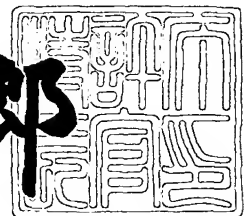
Applicant(s):

三洋電機株式会社

2003年 5月 9日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3033564



【書類名】 特許願

【整理番号】 RSL1030005

【提出日】 平成15年 1月27日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05B 33/20

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社  
社内

【氏名】 松本 昭一郎

【特許出願人】

【識別番号】 000001889

【氏名又は名称】 三洋電機株式会社

【代表者】 桑野 幸徳

【代理人】

【識別番号】 100111383

【弁理士】

【氏名又は名称】 芝野 正雅

【連絡先】 03-3837-7751 知的財産センター 東京事  
務所

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013033

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9904451

【プルーフの要否】 要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 エレクトロルミネッセンス表示装置及びエレクトロルミネッセンス表示装置のパターンレイアウト方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 発光領域を形成可能な画素領域が一定の規則で複数個配置されるエレクトロルミネッセンス表示装置において、

前記複数の画素領域がそれぞれ特定の色成分に対応付けられており、第 1 及び第 2 の色成分に対応づけられた画素領域が等しい面積に形成されると共に、第 3 の色成分に対応付けられた画素領域が前記第 1 及び第 2 の色成分に対応付けられた画素領域と異なる面積に形成され、

少なくとも 1 つの色成分に対応する前記画素領域内に、第 1 の方向で前記画素領域と長さが等しく、第 1 の方向と交差する第 2 の方向で前記画素領域よりも長さが短く前記発光領域が形成されることを特徴とするエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項 2】 各色成分に対応付けられた前記複数の画素領域は、前記第 1 の方向及び前記第 2 の方向のうち、一方が等しい長さに形成されることを特徴とする請求項 1 に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項 3】 前記複数の画素領域の配列に沿って複数の信号線が設けられ、前記複数の信号線は、前記複数の画素領域からそれぞれ一定の距離に形成されることを特徴とする請求項 2 に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項 4】 前記複数の画素領域の配列に沿って複数の駆動電源線が設けられ、前記複数の駆動電源線は、前記複数の画素領域からそれぞれ一定の距離に形成されることを特徴とする請求項 2 に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項 5】 前記画素領域の第 1 の方向の長さは各色成分を示す発光材料の特性の経時変化に応じて設定されることを特徴とする請求項 2 から請求項 4 のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項 6】 発光領域を形成可能な画素領域が一定の規則で複数個配置されるエレクトロルミネッセンス表示装置のパターンレイアウト方法において、

特性の差が最も小さい第 1 及び第 2 の発光材料が発光する色成分に対応付けられた前記画素領域の第 1 の方向の長さを等しくし、第 3 の発光材料が発光する色成分に対応付けられた前記画素領域の第 1 の方向の長さとは異なるように設定するステップと、

前記第 1 の方向と交差する第 2 の方向における前記画素領域の長さを共通に設定するステップと、

前記画素領域内に、前記第 1 の方向及び前記第 2 の方向の一方を前記画素領域と等しい長さに設定し、他方を前記画素領域よりも短いまたは等しい長さに設定して発光領域を決定するステップと、

を有することを特徴とするエレクトロルミネッセンス表示装置のパターンレイアウト方法。

【請求項 7】 前記発光材料の変更に伴う特性の変化に応じて、前記発光領域の前記他方の長さを変更して前記発光領域を再レイアウトすることを特徴とする請求項 6 に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置のパターンレイアウト方法。

【請求項 8】 前記発光材料の特性は、発光材料の経時変化によるものであることを特徴とする請求項 7 に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置のパターンレイアウト方法。

【請求項 9】 前記発光材料の経時変化によるものとは、発光材料の寿命または発光効率であることを特徴とする請求項 8 に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置のパターンレイアウト方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、エレクトロルミネッセンス (Electro luminescence ; E L) 自発光素子及び薄膜トランジスタ (T F T) を用いたカラー表示装置に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

近年、E L 素子を用いた E L 表示装置が、C R T や L C D に代わる表示装置と

して注目されている。この E L 表示装置のカラー化の方法として、赤・緑・青の 3 原色を発光する発光材料を用いる塗り分け方式や、単色の発光材料のカラーフィルターや色変換層を用いる方式などが提案されている。

## 【 0 0 0 3 】

塗り分け方式の場合、色ごとに異なる発光材料を用いるが、これらの発光材料は、色度、寿命、発光効率など、固有の特性を有する。一般に、カラー画像を表示するディスプレイにおいては、ホワイトバランスを取るため、各発光材料の色度から自動的に各発光に必要な輝度が求められる。それらの輝度は、与える電流密度にほぼ比例するため、発光効率の悪い発光材料において必要とされる輝度を得るには、他の発光領域よりも大きな電流密度を与えなければならない。しかしながら、そのような発光効率の悪い材料では、電流密度を大きくする分、発光材料自体に負荷がかかるため、発光材料の寿命が短くなり、その結果、E L 表示装置全体の寿命も短くなってしまうという問題があった。

## 【 0 0 0 4 】

図 9 は、上記の問題を鑑みて提案された特開 2 0 0 0 - 4 2 9 0 4 4 1 号公報の有機 E L 表示装置の概略を示す平面図である。ゲート信号線 5 1、ドレイン信号線 5 2 ならびに電源駆動線 5 3 とに囲まれた領域がマトリクス状に形成されている。その領域内に色ごとに異なる面積を有する発光領域 R 9 0、G 9 0、B 9 0 が形成されており、これが発光を視認できる領域を示している。なお、本図において、R は赤色、G は緑色、B は青色を示している。

## 【 0 0 0 5 】

色ごとに発光面積を異ならせるための基準は、各色を示す発光材料の発光効率である。発光効率の悪い発光材料を用いる発光領域を他の発光領域よりも大きくすることによって所望の輝度を確保するため、発光効率の悪い発光材料に過度の電流密度をかけずに済むので、寿命を延ばすことができる。

## 【 0 0 0 6 】

## 【特許文献 1】

特開 2 0 0 0 - 2 9 0 4 4 1 号公報（第 1 図）

## 【 0 0 0 7 】

## 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、図9に示すように、各信号線及び駆動線の間隔は、最も面積が広く設定される色に応じて設定されるため、スペースの利用効率が低く、高密度化に適さない。また、各色の発光材料の特性に応じて各画素領域の幅を全て異ならしめてレイアウトすることも考えられるが、発光材料が変更される度にレイアウトの変更をする必要が生じるため、多大な時間を必要とする。

## 【0008】

## 【課題を解決するための手段】

本発明は、以上の点を鑑みてなされたものであり、以下のような特徴を有する。

## 【0009】

発光領域を形成可能な画素領域が一定の規則で複数個配置されるエレクトロルミネッセンス表示装置において、前記複数の画素領域は、それぞれ特定の色成分に対応付けられると共に、第1及び第2の色成分に対応づけられた画素領域が等しい面積に形成されると共に、第3の色成分に対応付けられた画素領域が前記第1及び第2の色成分に対応付けられた画素領域と異なる面積に形成され、少なくとも1つの色成分に対応する前記画素領域内に、第1の方向で前記画素領域と長さが等しく、第1の方向と交差する第2の方向で前記画素領域よりも長さが短く前記発光領域が形成されることを特徴とする。

## 【0010】

これにより、スペースを有効に利用できるので、発光領域を大きくすることができる。また、2つの色成分に対応する画素領域を等しく設定することができるので、レイアウトに要する時間の短縮をより図ることができる。

## 【0011】

また、発光領域を形成可能な画素領域が一定の規則で複数個配置されるエレクトロルミネッセンス表示装置のパターンレイアウト方法において、特性の差が最も小さい第1及び第2の発光材料が発光する色成分に対応付けられた前記画素領域の第1の方向の長さを等しくし、第3の発光材料が発光する色成分に対応付けられた前記画素領域の第1の方向の長さと異なるように設定するステップと、前

記第 1 の方向と交差する第 2 の方向における前記画素領域の長さを共通に設定するステップと、前記画素領域内に、前記第 1 の方向及び前記第 2 の方向の一方を前記画素領域と等しい長さに設定し、他方を前記画素領域よりも短いまたは等しい長さに設定して発光領域を決定するステップと、を有することを特徴とする。

#### 【 0 0 1 2 】

これにより、スペースを有効に利用できるので、発光領域を大きくすることができる。また、2つの色成分に対応する画素領域を等しく設定することができるので、レイアウトに要する時間の短縮をより図ることができる。

#### 【 0 0 1 3 】

##### 【発明の実施の形態】

図 1 は、第 1 の実施の形態に係る E L 表示装置の発光領域を示す平面図である。この図においては、3 原色 (R・G・B) の各色成分に対応する発光領域が行方向に周期的に配置され、且つ、同じ色成分が同一列に配置されるストライプ配列の場合を示している。ここで、各色成分を示す発光材料の寿命は、 $G > R > B$  の関係にあり、また 3 つの寿命の差を取った場合に最も小さくなる組合せが G と R であると仮定している。なお、寿命とは、特定の電流密度で連続発光させた時に、輝度が初期輝度の 50% になる輝度半減期を指し、時間経過に伴う発光材料の劣化状況を表す要素の 1 つである。

#### 【 0 0 1 4 】

図の画素領域  $P_R$ 、 $P_G$ 、 $P_B$  は、各色成分の発光が視認される発光領域  $E_R$ 、 $E_G$ 、 $E_B$  を形成可能な領域であり、共通の高さ (垂直方向の長さ)  $H$  と、色成分に応じた固有の幅 (水平方向の長さ)  $W_R$ 、 $W_G (=W_R)$ 、 $W_B$  をそれぞれ有する。ここで、寿命の差が小さい R 及び G は等しい幅となっている。各色を発光する発光領域  $E_R$ 、 $E_G$ 、 $E_B$  は、画素領域  $P_R$ 、 $P_G$ 、 $P_B$  の高さ  $H$  よりも低く、且つ色成分に応じた固有の高さ  $H_R$ 、 $H_G$ 、 $H_B$  と、対応した発光領域と等しい幅  $W_R$ 、 $W_G (=W_R)$ 、 $W_B$  をそれぞれ有する。ここで、幅を等しくした R 及び G の発光材料の寿命の差は、その高さ  $H_R$  及び  $H_G$  により調節されている。これにより、画素領域  $P_R$ 、 $P_G$ 、 $P_B$  の 1 辺に沿って、マージン  $M_R$ 、 $M_G$ 、 $M_B$  (図のハッチング) が形成される。なお、発光領域の高さ  $H_R$ 、 $H_G$ 、 $H_B$  を対応する画素領域の高さ  $H$



と等しくし、発光領域の幅 $W_R$ 、 $W_G$ 、 $W_B$ を各発光領域の幅よりも短い固有の値 $W_R'$ 、 $W_G'$ 、 $W_B'$ としても良い。画素領域及び発光領域の高さ及び幅の長さの設定方法、つまりパターンレイアウト方法については後述する。

## 【0015】

以上のようにして配置された複数の画素領域 $P$ の周辺に、複数のゲート信号線51が水平方向に、複数のドレイン信号線52及び複数の駆動電源線53が垂直方向に形成されている。ゲート信号線51から画素領域までの距離 $D_H$ 、駆動電源線53から画素領域までの距離 $D_W$ は、各画素領域 $P_R$ 、 $P_G$ 、 $P_B$ の幅 $W_R$ 、 $W_G$ 、 $W_B$ に関係なく、それぞれ一定になるように設定されている。これは、各画素領域 $P$ の周辺にゲート信号線51及び駆動電源線53を配置した時に、画素領域 $P$ の上側及び左側に形成される空間が共通の形状となるようにするためである。画素領域 $P$ 周辺の平面構造は後述するが、これによって、各信号線に囲まれる領域内に設置されるTFTや保持容量電極などの構成要素を共通の構造・配置にすることができるので、各領域内の設計がしやすくなり、さらには、後述する発光材料の変更に際して、それらの構成要素の構造・配置を変更しなくても良いという利点がある。なお、画素領域周辺のレイアウトはこれに限らず、 $D_H$ 、 $D_W$ の距離をあける場所は、下側及び右側やこれらを組み合わせた位置に設けても良い。

## 【0016】

以上に述べたようなレイアウトにおいては、各画素領域内のスペースの無駄がなくなると共に、発光領域の面積を修正するために必要なマージンを確保できる。さらに、2つの画素領域の幅が等しいので、より設計がしやすい。

## 【0017】

図2(a)は、本実施の形態におけるパターンレイアウト方法を説明するフローチャートである。以下、このチャートに沿って、各領域の設定及び変更の仕方について説明する。

## 【0018】

ステップS1では、各発光材料の輝度を測定する。まず、各色の発光材料の色度から、ホワイトバランスが取れるような理想輝度 $L_1$ が色成分ごとに決まる。一方で、全ての発光材料の輝度半減期が、おおよその目標値 $T$ になるような電流

密度  $I_0$  を各材料で探し、そのときの発光輝度  $L_0$  をそれぞれ測定しておく。

#### 【0019】

ステップ S 2 では、画素領域  $P_R$ 、 $P_G$ 、 $P_B$  の幅  $W_R$ 、 $W_G$ 、 $W_B$  を設定する。まず、ステップ S 1 で測定した輝度  $L_0$  と理想輝度  $L_I$  の比  $L_I/L_0$  (輝度比) を色成分ごと取る。そして、輝度比の差が最小になる 2 つの色成分に対応した画素領域の幅を等しくする。他の色成分に対応した画素領域の幅は、先の 2 つの輝度比のどちらか一方、またはその平均に応じて設定する。例えば、各色の輝度比が  $R : G : B = 1.2 : 1 : 3$  の場合、輝度比の差が最も小さくなる発光材料の組合せは、R と G である。よって、 $W_R$  と  $W_G$  を等しく設定し、 $W_B$  を R と G の輝度比の一方またはその平均に応じて設定する。すなわち、R の輝度比に応じて設定する場合は、 $W_R : W_G : W_B = 1.2 : 1.2 : 3$  となり、R と G の輝度比の平均に応じて設定する場合は、 $W_R : W_G : W_B = 1.1 : 1.1 : 3$  となる

ステップ S 3 では、画素領域 P の高さを共通の高さ H に設定する。このとき、高さ H を、予測される 1 つの色成分に対応した発光領域 E の高さよりもやや長く設定し、マージン M を設けることのできる空間を取っておく。後のステップで、各色成分の輝度比に応じて面積を設定する場合に、発光領域 E の高さ  $H_R$ 、 $H_G$ 、 $H_B$  で調節するための自由度を保つためである。また、発光領域 E の高さ  $H_R$ 、 $H_G$ 、 $H_B$  を設定し直すことになった場合や、発光材料を変更する場合に対応するためでもある。先のステップ S 2 とこのステップ S 3 によって、発光領域 E を最大限に広げることのできる画素領域 P が設定される。

#### 【0020】

ステップ S 4 では、発光領域  $E_R$ 、 $E_G$ 、 $E_B$  をそれぞれ設定する。まず、発光領域 E の幅を、対応する画素領域 P の幅  $W_R$ 、 $W_G$ 、 $W_B$  と等しく設定する。次に、各色成分に対応した発光領域の面積の比が各色成分の輝度比の比に対応するように、発光領域 E の高さを設定する。ステップ S 2 で、輝度比の比と正確に対応して各画素領域 P の幅  $W_R$ 、 $W_G$ 、 $W_B$  を設定しているわけではないので、ほとんどの場合、各色成分に対応した発光領域 E の高さ  $H_R$ 、 $H_G$ 、 $H_B$  が異なる。つまり、輝度比の差が小さい 2 つの色成分に対応する画素領域 P の幅を等しくしているので、その輝度比の差の分だけ発光領域 E の高さが異なる。しかし、輝度比の

差が最も小さくなる色成分を選んでいるので、発光領域Eの高さが極端に異なることはない。また、その2つの色成分以外の色成分に対応した発光領域の高さも、輝度比の比に応じて画素領域の幅を設定しているので、その2つの色成分に対応した発光領域の高さとほぼ等しくなる。例えば、ステップS2で例示した各色の輝度比が $R : G : B = 1.2 : 1 : 3$ であって、 $W_R : W_G : W_B = 1.2 : 1 : 2 : 3$ とした場合、 $H_R : H_G : H_B = 1.2 / 1.2 : 1 / 1.2 : 1 / 1.2 = 1.2 : 1 : 1.2$ となる。

## 【 0 0 2 1 】

ステップS5では、以上のステップで設定した値で試作、もしくはシミュレーション等を行い、表示として問題がないか確認する。例えばホワイトバランスが取れているか等である。問題がなければレイアウト終了となり、問題があればステップS4に戻る。例えば、Bの輝度が不足していることがわかった場合、Bに対応する発光領域の高さ $H_B$ を高くするなどすれば良い。

## 【 0 0 2 2 】

以上の方法によって、発光材料の輝度半減期に応じて各色成分に対応した画素領域及び発光領域を設定することができる。この方法によれば、特性の近い発光材料の発光領域の幅を等しくしても、発光領域の高さを微調整することによって、そのわずかな特性の違いにも正確に対応することができる。なお、高さが最も高く設定される発光領域を画素領域と同じ高さにすることにより、画素領域をもっとも効率よく使うことができる。また、本実施の形態においては、発光領域の上部にマージンMを設けて材料変更等に対応していたが、発光領域Eの下部または左右どちらか一方にマージンMを設けた場合も同様であり、マージンMが設けられた発光領域Eの幅を変えて材料変更に対応することもできる。この場合は、発光領域の高さを固定したままその幅を変更すれば良い。

## 【 0 0 2 3 】

図2(b)は、材料の改良その他の理由により発光材料に変更があった場合の、発光領域の変更の方法を示すフローチャートである。一例として、改良によりBの材料が改良前の条件と同じ条件において、輝度半減期Tにおける電流密度が $I_0$ から $I_1 (> I_0)$ に変わった場合を考える。

## 【 0 0 2 4 】

ステップ S 1 では、変更された材料の輝度を測定する。変更された B の発光材料の輝度半減期が、おおよその目標値 T になるような電流密度  $I_1$  を探し、そのときの発光輝度  $L_1$  を測定する。

## 【 0 0 2 5 】

ステップ S 2 では、B の発光領域の高さを設定する。ステップ S 1 で測定した、電流密度  $I_1$  での輝度  $L_1$  と、変更前の B の電流密度  $I_0$  における輝度  $L_0$  との変化割合  $L_1 / L_0$  に応じて各色成分に対応した発光領域 E の高さを変更する。この変更の仕方には 3 つあり、以下にそれらの方法を説明する。

## 【 0 0 2 6 】

第 1 の方法は、変化割合 X に応じて、発光材料が変更される B 以外の R および G に対応する発光領域の高さを変更前より高くすることで、各色のバランスを取る方法である。本実施の形態においては、最初に画素領域及び発光領域を設定する際に、対応する全ての画素領域内にマージン M を設ける。このため、発光領域を広げる変更を加えれば、各色の輝度が増加し、全体の輝度も増加する。

## 【 0 0 2 7 】

第 2 の方法は、先に述べた変化割合 X に応じて、発光材料が変更される B に対応する発光領域の高さを変更前より低くすることで、各色のバランスを取る方法である。この方法は、高さの修正の繰り返しなどにより、材料変更のない発光領域 R、G の少なくとも一方が、すでに画素領域と等しい高さになっており、それ以上高さを高くできない時に有効である。

## 【 0 0 2 8 】

第 3 の方法は、先の第 1 の方法と第 2 の方法の組合せであり、この場合、変更の自由度があるため、柔軟な対応ができる。

## 【 0 0 2 9 】

以上の方法は、材料変更によって、輝度半減期 T を実現する輝度が変わることのみを問題としていたが、実際は、材料が変わると色度も変わることが多く、この場合、ホワイトバランスを取るための理想輝度が、各色成分で変わってしまう。そこで、先に述べた色成分ごとに輝度比を求め直し、その輝度比が、各色成分

に対応した発光面積に対応するように発光領域の高さをそれぞれ再設定する。この場合、上記第 3 の方法が有効、且つ実用的である。

#### 【 0 0 3 0 】

続いてステップ S 3 では、図 2 ( a ) におけるステップ S 5 と同様に、これまでの設定で問題ないかを判定する。ステップ S 2 で設定した値で試作、もしくはシミュレーション等をし、表示装置として問題がないかを確認し、問題がなければレイアウト終了となり、問題があればステップ S 2 に戻る。

#### 【 0 0 3 1 】

以上に述べた方法によれば、発光領域 E の高さを変更するだけで、発光領域以外のレイアウトを全く変更しなくても、材料の変更に伴う発光特性の変化に対応することができる。従って、製造工程に用いられるマスクの変更が最小限で良い。具体的には、発光領域を定めるマスクを最少で 1 枚変更するだけである。また、1 つの色成分に対応した発光領域 E の高さを画素領域 P の高さ H と等しく形成しても、他の色成分の発光領域の高さを調整することにより、材料の変更に伴う発光特性の変化に対応することができる。この場合、画素領域の高さ H と等しい高さに形成する発光領域は、発光面積を最も大きく形成する必要のある色成分に対応する発光領域であることが好ましい。なお、本実施の形態においては B の発光材料を変更する場合についてのみ説明したが、G または R の場合でも同様であり、また、2 色以上の発光材料が変更される場合も適用できる。

#### 【 0 0 3 2 】

図 3 は本実施の形態の画素領域  $P_B$  周辺の構造を示す平面図であり、図 4 ( a ) 及び ( b ) は、図 3 の A - A 及び B - B 断面図である。以下、図 3 を用いて本実施の形態の画素領域 P とその周辺の構造について説明する。

#### 【 0 0 3 3 】

発光領域  $E_B$  が、画素領域  $P_B$  の上部にマージン M を設けるようにして、画素領域  $P_B$  内に配置されている。また、直列に接続される 2 つの第 1 の TFT 1 0、及び保持容量電極線 5 4 ならびに保持容量電極 5 5 の一部が、画素領域  $P_B$  とゲート信号線 5 1 の間に配置されている。さらに、2 つの TFT 1 0 のゲート 1 4 が、ゲート信号線 5 1 にそれぞれ接続されている。また、ドレイン信号線 5 2 側

のTFT10のドレイン12dが、ドレイン信号線52に接続されている。ドレイン信号線52に直接接続されていないTFT10のソース12sが、保持容量電極線54との間で保持容量 $C_S$ をなす保持容量電極55につながっている。さらに、TFT10のソース12sが、並列に接続される2つの第2のTFT20のゲート電極24に接続されている。2つのTFT20のソース22sが、駆動電源線53にそれぞれ接続されている。また、2つのTFT20のドレイン22dが、ドレイン電極26に接続されており、さらにはそのドレイン電極26を介して有機EL素子の電極61に接続されている。

## 【0034】

また、保持容量電極線54は、ゲート絶縁膜13を介して、TFT10のソース12sに接続された保持容量電極55を兼ねた導電層13に対向するように形成されている。これにより、保持容量電極線54と保持容量電極55との間で電荷を蓄積して容量を成している。この容量は、第2のTFT20のゲート電極24に印加される電圧を保持する保持容量 $C_S$ となる。

## 【0035】

この図において、画素領域 $P_B$ 及び発光領域 $E_B$ は長方形で示されているが、実際は少しでも発光面積を確保するために、または設計上の都合で長方形でない場合もある。本明細書においては、厳密に長方形でないものも、大まかに見て長方形と捉えることができる範囲であれば、長方形とみなす。さらに、マージンMを設ける場所は本実施の形態に限らず、画素領域の一边に偏らせれば良い。なお、本図では、Bに対応した画素領域 $P_B$ とその周辺構造について説明したが、G及びRに対応した画素領域 $P_G$ 及び $P_R$ とその周辺構造もほぼ共通である。

## 【0036】

ここで、スイッチング用のトップゲート型TFTである第1のTFT10とそのソースに接続する保持容量 $C_S$ の構造について説明する。基板10上に、例えばSiN、SiO<sub>2</sub>からなる絶縁膜11が積層されている。その上に、多結晶シリコン（以降、p-Siと略す）膜からなる能動層12が形成されており、同じp-Siからなる保持容量電極55に接続されている。なお、能動層12には、ドレイン12d、ソース12s及びその間に位置するチャンネル12cが設けられ

ている。さらに、その能動層 1 2 及び保持容量電極 5 5 を覆うようにして  $\text{SiO}_2$ 、 $\text{SiN}$  からなるゲート絶縁膜 1 3 が積層されている。その上に、クロム (Cr)、モリブデン (Mo) 等の高融点金属からなるゲート電極 1 4 及び保持容量電極線 5 4 が形成されている。なお、ゲート電極 1 4 は、チャネル 1 2 c をまたぐようにして設けられており、保持容量電極線 5 4 は、保持容量電極 5 5 に対向するように設けられている。これにより第 1 の TFT 1 0 が構成される。

## 【 0 0 3 7 】

さらに、ゲート電極 1 4 及びゲート絶縁膜 1 3 上の全面に、 $\text{SiO}_2$  膜、 $\text{SiN}$  膜等からなる層間絶縁膜 1 5 が形成されている。この層間絶縁膜 1 5 のドレイン 1 2 d に対応する位置に形成したコンタクトホールを通して、Al 等の金属からなるドレイン電極 1 6 が設けられ、さらに全面に、有機樹脂からなり表面を平坦にする平坦化膜 1 7 が形成されている。

## 【 0 0 3 8 】

次に、有機 EL 素子の駆動用のトップゲート型 TFT である第 2 の TFT 2 0 の構造について説明する。基板 1 0 上に、例えば  $\text{SiN}$ 、 $\text{SiO}_2$  からなる絶縁膜 1 1 が積層されている。その上に、p-Si 膜からなる能動層 2 2 が形成されている。なお、能動層 2 2 には、ドレイン 2 2 d、ソース 2 2 s 及びその間に位置するチャネル 2 2 c が設けられている。さらに、その能動層 2 2 を覆うようにして  $\text{SiO}_2$ 、 $\text{SiN}$  からなるゲート絶縁膜 1 3 が積層されている。その上に、チャネル 2 2 c をまたぐようにして Cr、Mo 等の高融点金属からなるゲート電極 2 4 が形成されている。これにより、第 2 の TFT 2 0 が構成される。

## 【 0 0 3 9 】

さらに、ゲート電極 2 4 及びゲート絶縁膜 1 3 上の全面に、 $\text{SiO}_2$  膜、 $\text{SiN}$  膜等からなる層間絶縁膜 1 5 が形成されている。この層間絶縁膜 1 5 のソース 2 2 s 及びドレイン 2 2 d に対応する位置に形成したコンタクトホールを通して、金属からなるドレイン電極 2 6 と、駆動電源に接続された駆動電源線 5 3 と、が配置されている。さらに、表面を平坦にするための有機樹脂からなる平坦化膜 1 7 が積層され、その平坦化膜 1 7 を貫通し、ドレイン電極 2 6 に接続した ITO (Indium Tin Oxide) からなる電極 6 1 が平坦化膜 1 7 上に

形成されている。次いで、電極 6 1 上に、ホール輸送層 6 2 と、発光層 6 3 と、電子輸送層 6 4 との 3 層からなる発光素子層 6 5 が積層形成され、さらにこの発光素子層 6 5 を覆うようにして、アルミニウム合金などからなる電極 6 6 が形成されている。ここで、ホール輸送層 6 2 と電極 6 1 の間には、絶縁樹脂からなる第 2 平坦化膜 6 7 が積層形成されており、電極 6 1 上に設けられる開口部によって、電極 6 1 が露出する領域を制限している。つまり、発光領域 E は、第 2 平坦化膜 6 7 の開口部分によって定義される。さらに、本図における画素領域 P は、電極 6 1 によって定義される。

## 【 0 0 4 0 】

本実施の形態の E L 表示装置の発光領域 E を設定された形状に製造する方法としては、先に述べた第 2 平坦化膜 6 7 を用いる第 1 の方法の他に、第 2 平坦化膜 6 7 を用いず、図 5 ( a ) に示すように、有機 E L 素子の電極 6 1 の形状によって調節する第 2 の方法がある。この場合の発光領域 E は電極 6 1 で定義され、画素領域 P は発光層 6 3 で定義される。また、同じく第 2 平坦化膜 6 7 を用いず、図 5 ( b ) に示すように、発光層 6 3 によって調節する第 3 の方法もある。この場合の発光領域 E は発光層 6 3 で定義され、画素領域 P は電極 6 1 で定義される。

## 【 0 0 4 1 】

図 6 ( a ) ～ ( d ) は本実施の形態における E L 表示装置の製造方法を示す製造工程別の断面図である。これらの図は図 3 の B - B 断面図に一致する。この図に沿って、第 1 の方法を用いた E L 表示装置の製造工程について説明する。

## 【 0 0 4 2 】

図 6 ( a ) は第 1 の工程における断面図である。この工程では、まず、既存の方法により第 2 の T F T 2 0 を形成し、 T F T 2 0 を覆うように層間絶縁膜 1 5 を積層した後、 T F T 2 0 のソース 2 2 s と接続された駆動電源線 5 3、 T F T 2 0 のドレイン 2 2 d と接続されたドレイン電極 2 6 を形成する。その上に平坦化膜 1 7 を積層した後に、この平坦化膜 1 7 を貫通し、且つドレイン電極 2 6 に到達するようなコンタクトホール C T を形成する。そして、このコンタクトホール C T を通して、平坦化膜 1 7 の全面を覆うような透明材料、 I T O 層 2 8 をス



パッタ法により積層する。

【0043】

図6(b)は第2の工程における断面図である。この工程では、まず、ITO層28の上にレジストを塗布し、マスクを用いて露光し、現像することによってレジストをパターンニングする。次に、そのレジストをマスクとし、ITO層28をエッチングすることによって、電極61を形成する。

【0044】

図6(c)は第3の工程における断面図である。この工程では、まず、電極61及び平坦化膜17上に、有機樹脂からなる第2平坦化膜材料をスピコート法などによって積層する。次に、マスク105を用いてこの第2平坦化膜材料を露光し、現像することによって第2平坦化膜67を形成する。ここで用いるマスク105は、例えば図7に示すように、複数の開口部R50、G50、B50を有している。マスクの各開口部R50、G50、B50は、発光領域と同じ幅 $W_R$ 、 $W_G$ 、 $W_B$ 及び高さ $H_R$ 、 $H_G$ 、 $H_B$ を有する。これにより、発光領域Eに対応する形状と位置に、第2平坦化膜67の開口部が形成される。その開口部が形成された領域に、電極61が露出する。

【0045】

図6(d)は第4の工程における断面図である。この工程では、まず、露出した電極61を覆うようにして平坦化膜67上にホール輸送層62を基板全面に蒸着する。次に、マスクを用いて、発光材料ごとに蒸着し、発光層63を形成する。続いて、電子輸送層64を基板全面に蒸着する。以上より形成されたホール輸送層62、発光層63、電子輸送層64からなる発光素子層65上に、マスクを用いて電極66を蒸着する。なお、これらの発光材料の抵抗は比較的高いので、電極61と電極66に挟まれている領域にある発光素子層65が発光領域となる。また、ホール輸送層62と電子輸送層64は共に基板全面に形成したが、発光材料ごとに異なる輸送層材料を用いても良い。

【0046】

以上より、各色ごとに所望の発光領域を有する有機EL素子を用いたカラー表示装置が得られる。

## 【 0 0 4 7 】

次に、第2の方法である、電極61によって発光領域Eを調節する製造方法について説明する。この方法は、先に説明した第1の方法とほぼ同様な工程で良いが、第2平坦化膜67を形成しない点で異なる。つまり、マスクを用いて電極61を発光領域と同じ形状と位置に形成し、その上に、電極61を覆うような発光素子層65と電極66を形成する。これによって、図5(a)のような断面構造を有するEL表示装置が得られる。なお、電極61形成用のマスクは、例えば先の図7のマスクと同様に、発光領域Eに対応する位置と形状に開口部を有するものを用いれば良い。

## 【 0 0 4 8 】

次に、第3の方法である、発光層63によって発光領域Eを調節する製造方法について説明する。この方法は先に説明した第2の方法とほぼ同様な工程で良いが、電極61を発光領域より大きく形成し、マスクを用いて発光層63を発光領域Eと同じ形状と位置に形成する。これによって、図5(b)のような断面構造を有するEL表示装置が得られる。なお、発光層63形成用のマスクは、例えば先の図7のマスクと同様に、発光領域Eに対応する位置と形状に開口部を有するものを用いれば良い。ただし、色成分ごとに異なる発光材料を用いるので、その数だけマスクが必要である。この場合、各マスクは、1つの色成分に対応する発光領域Eに対応する開口部をそれぞれ有する。

## 【 0 0 4 9 】

本実施の形態においては、画素領域P内にマージンMを設けて発光領域Eを設定することにより、既に設計された発光領域の幅を変えずに、画素領域の範囲内において発光領域の高さを調節することができる。これによって、材料の変更があっても、同じホワイトバランスを得ることができる。この時、ゲート信号線51、ドレイン信号線52及び駆動電源線53に囲まれる領域自体の大きさやレイアウトを変える必要がないので、マスクを変更する枚数が最少で1枚に抑えることができる。例えば、第2平坦化膜67を用いてEL表示装置を製造する場合は、発光領域の高さの変更にあわせて、第2平坦化膜67形成用のマスク105の開口部の高さを変更するだけで良い。つまり、第2平坦化膜67形成用のマスク

を 1 枚変えるのみで対応できる。また、電極 6 1 が、発光領域 E よりは大いものの、画素領域 P より小さく形成されている、つまり画素領域 P が電極 6 1 で定義されない場合も考えられる。この場合、発光領域 E の高さを高くすることによって電極 6 1 より高くなってしまったときには、発光領域 E の高さを変えるために第 2 平坦化膜 6 7 形成用のマスクを変更すると共に、電極 6 1 形成用のマスクも変更しなければならない。この場合は、マスクを 2 枚変更する必要がある。

## 【 0 0 5 0 】

次に、第 2 の実施の形態に係る E L 表示装置の発光領域を示す平面図を図 8 に示す。図 8 では、第 1 の実施の形態と同様にして設定された画素領域  $P_R$ 、 $P_G$ 、 $P_B$  と発光領域  $E_R$ 、 $E_G$ 、 $E_B$  が、奇数行と偶数行とで約 1.5 画素領域分ずれて配置されており、互いに隣接する 3 つの画素領域をどのように選んでも、 $R \cdot G \cdot B$  の組み合わせになる、いわゆるデルタ配列となっている。

## 【 0 0 5 1 】

画素領域 P と発光領域 E は、第 1 の実施の形態と同様であり、これらの画素領域と発光領域を取り囲むように、複数のゲート信号線 5 1 が水平方向に配置されている。また、複数のドレイン信号線 5 2 及び複数の駆動電源線 5 3 が図の垂直／水平方向に配置されている。さらに、ゲート信号線 5 1 とドレイン信号線 5 2 または駆動電源線 5 3 は互いに交差している。

## 【 0 0 5 2 】

なお、本実施の形態のようなデルタ配列の場合、パターンレイアウトの都合上、隣り合う行に配置された同色の画素領域の幅が多少異なってしまうことがあり、そのときは、互いが同面積になるように発光領域の高さまたは幅を調節すれば良い。なお、本実施の形態において発光材料を変更する場合も、発光領域を変更するだけで良く、変更すべきマスク数は最少で 1 枚に抑えることができる。

## 【 0 0 5 3 】

本発明は、以上の実施の形態に限られるものではなく、各発光領域の配列方法はストライプ配列・デルタ配列の他にダイアゴナル配列などでも良い。また、発光領域の形状は長方形に限らず平行四辺形や L 字型などでも良い。なお、L 字型の場合は、L 字から合理的に長方形等を取り出し、その高さを発光領域の高さ H

$R$ 、 $H_G$ 、 $H_B$ とみなし、この高さを色成分毎の輝度比に応じて調節することによって、発光領域を設定・再レイアウトすれば良い。発光領域をTFTの製造方法・各材料は既存のものを用いれば良く、TFTの構造は、ボトムゲート型だけでなく、ゲート電極が能動層の上に設けられるいわゆるトップゲート型でも良い。また、輝度半減期に基づいて発光面積を設定・変更することについてのみ説明したが、例えば発光効率のように、発光材料に固有な特性や時間経過に伴って変化する特性に基づいて発光面積を設定・変更することも可能である。その場合、寿命を発光効率などに読みかえれば良い。

## 【 0 0 5 4 】

本実施の形態では、発光層からの光を、TFT基板側を通して裏面側へ出力するボトムエミッション型のEL表示装置を説明したが、発光層からの光をTFT基板表面側から出力するトップエミッション型のEL表示装置にも適用できる。また、

## 【 0 0 5 5 】

## 【発明の効果】

以上、本願発明によれば、無駄なスペースが生じることなく発光領域を配置することができるので、各発光領域をより大きく形成することができる。加えて、各発光材料の寿命を揃えることもできるので、累積使用時間が多くなってもホワイトバランスの取れた状態が保たれる、高品質なEL表示装置を提供することができる。

## 【 0 0 5 6 】

また、画素領域内に発光領域が設けられているので、その画素領域の範囲内で発光領域の大きさを変更することによって、材料を変更した後の発光材料の寿命や発光効率など、経時変化する特性に対応することができる。よって、発光領域以外のTFTや保持容量 $C_S$ のレイアウトを変更する必要がなく、平面レイアウトの設計期間や製造期間を短縮することができる。さらに、2つの色成分に対応した画素領域の一方向の長さが等しく設定されるので、レイアウトがより簡単になる。さらに、平面レイアウトを変更する場合、それに伴って、EL表示装置の構成要素を形成する各層も設計・製造変更しなおす必要が生じるが、本発明では

発光領域のみを変更するので、各層の設計・製造変更に要する期間が短縮できる。ゆえに、これらの設計・製造期間の短縮によって、E L表示装置の設計・製造にかかるコストを大幅に削減することができる。この際、発光領域に関係するE L素子の構成要素である電極、電極上に形成される平坦化膜、及び発光層のうち、変更が必要なものだけを作りかえれば良い。つまり、変更のある構成要素を形成するためのマスクのみを作り直すだけで良く、変更するマスク数は最少1枚で良い。ゆえに、マスクを再び作ることによって生じるコストも大幅に削減することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施の形態におけるE L表示装置の発光領域を示す平面図

【図2】 本発明の実施の形態におけるE L表示装置のレイアウトのフローチャート

【図3】 本発明の実施の形態におけるE L表示装置の画素領域周辺の平面図

【図4】 本発明の実施の形態におけるE L表示装置の断面図

【図5】 本発明の実施の形態におけるE L表示装置の第2のT F Tの断面図

【図6】 本発明の実施の形態におけるE L表示装置の製造工程別断面図

【図7】 本発明の実施の形態におけるE L表示装置の電極極形成用マスク

【図8】 本発明の他の実施の形態におけるE L表示装置の発光領域を示す平面図

【図9】 従来のE L表示装置の発光領域を示す平面図

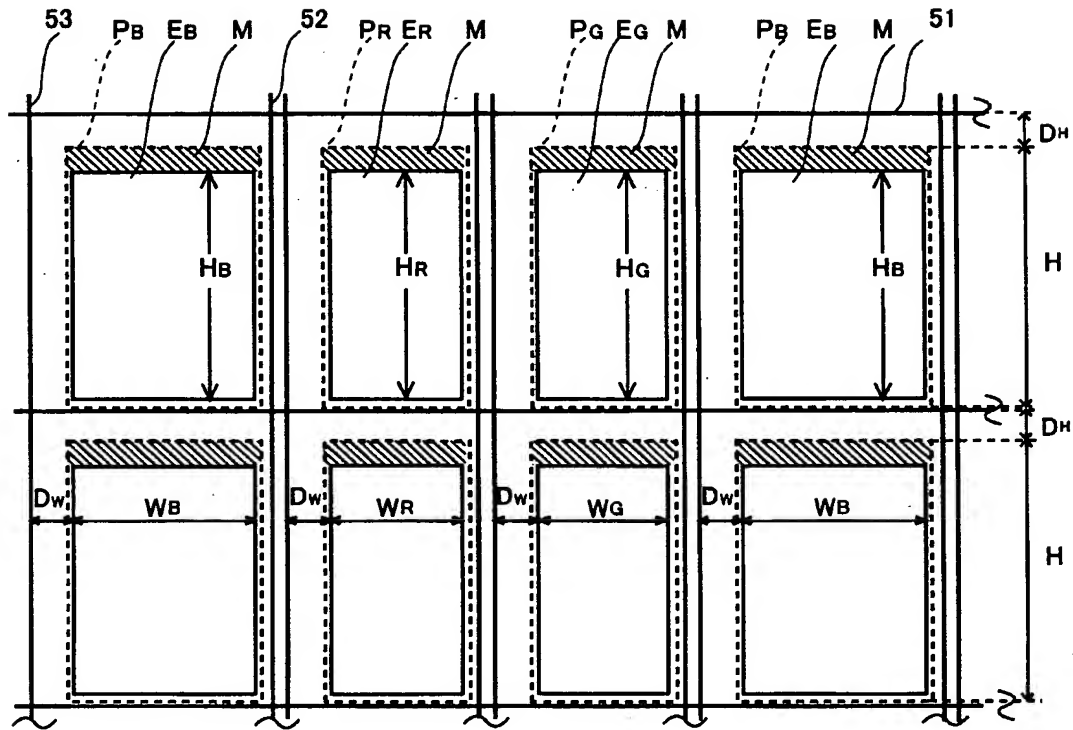
#### 【符号の説明】

1 0、2 0	T F T
1 1、1 3、1 5	絶縁膜
1 2、2 2	能動層
1 2 s、2 2 s	ソース
1 2 d、2 2 d	ドレイン
1 4、2 4	ゲート電極
1 6、2 6	ドレイン電極
1 7、6 7	平坦化膜

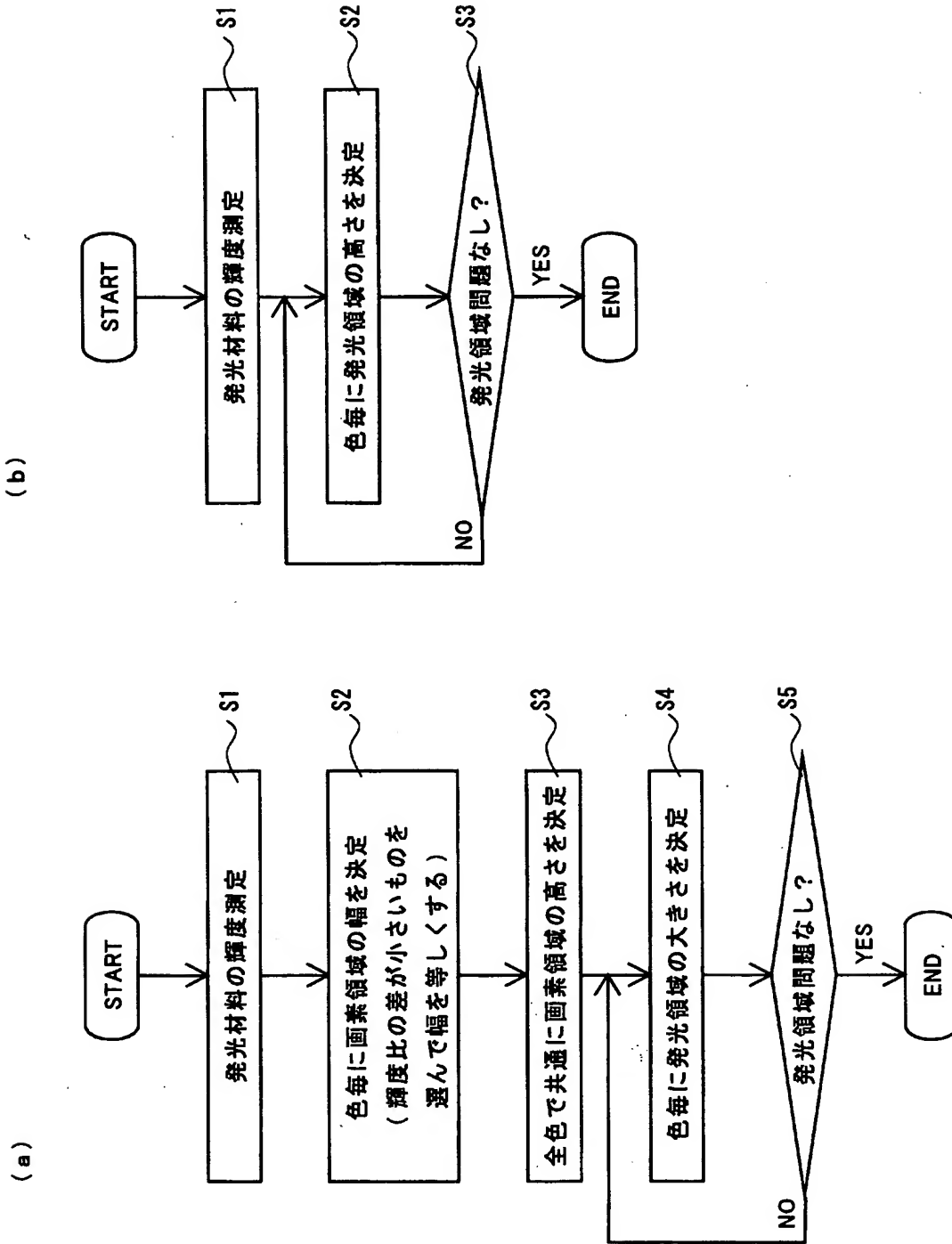
5 1	ゲート信号線
5 2	ドレイン信号線
5 3	駆動電源線
5 4	保持容量電極線
6 1、6 6	電極
6 2	ホール輸送層
6 3	発光層
6 4	電子輸送層
1 0 5	マスク

【書類名】 図面

【図 1】

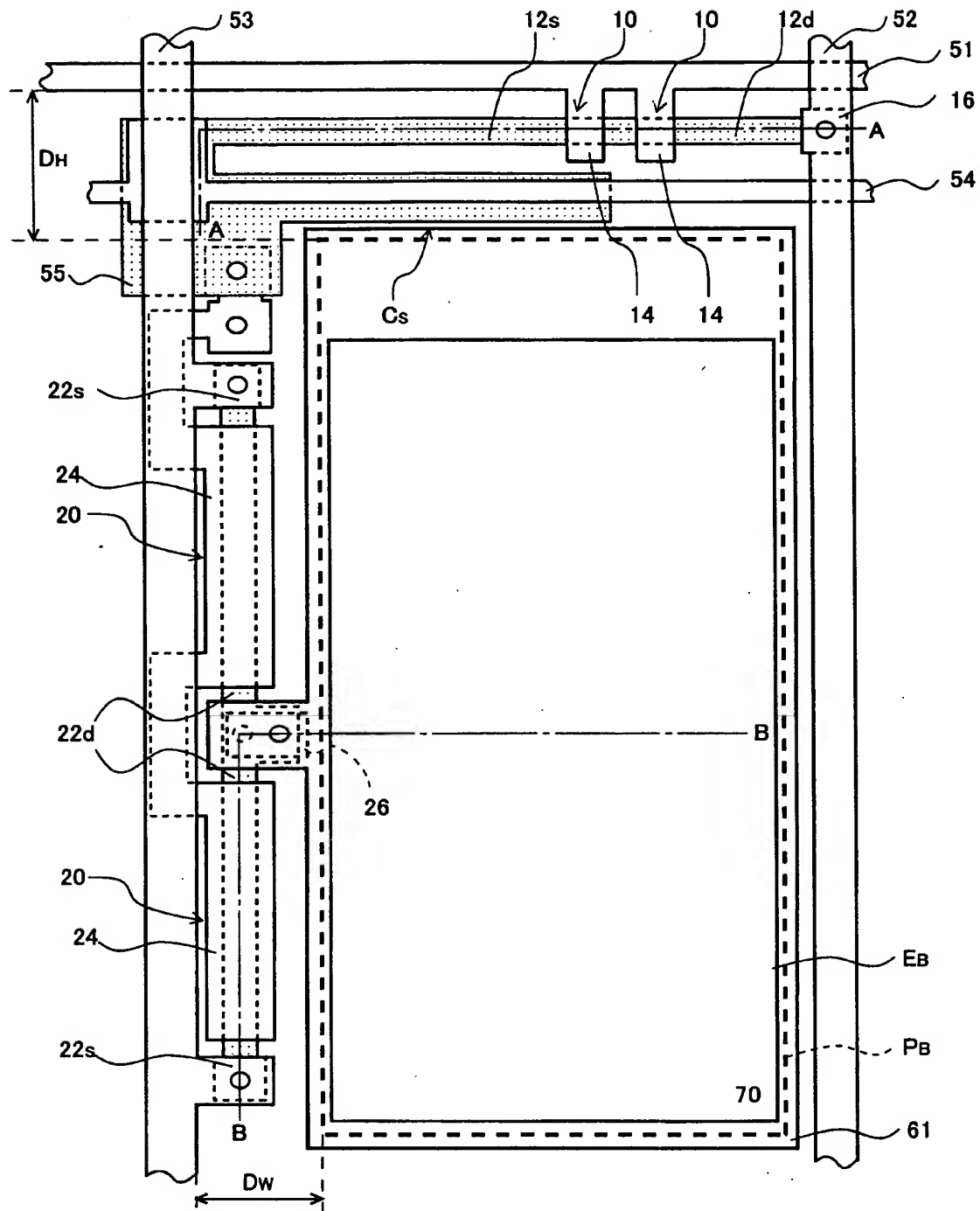


【図 2】

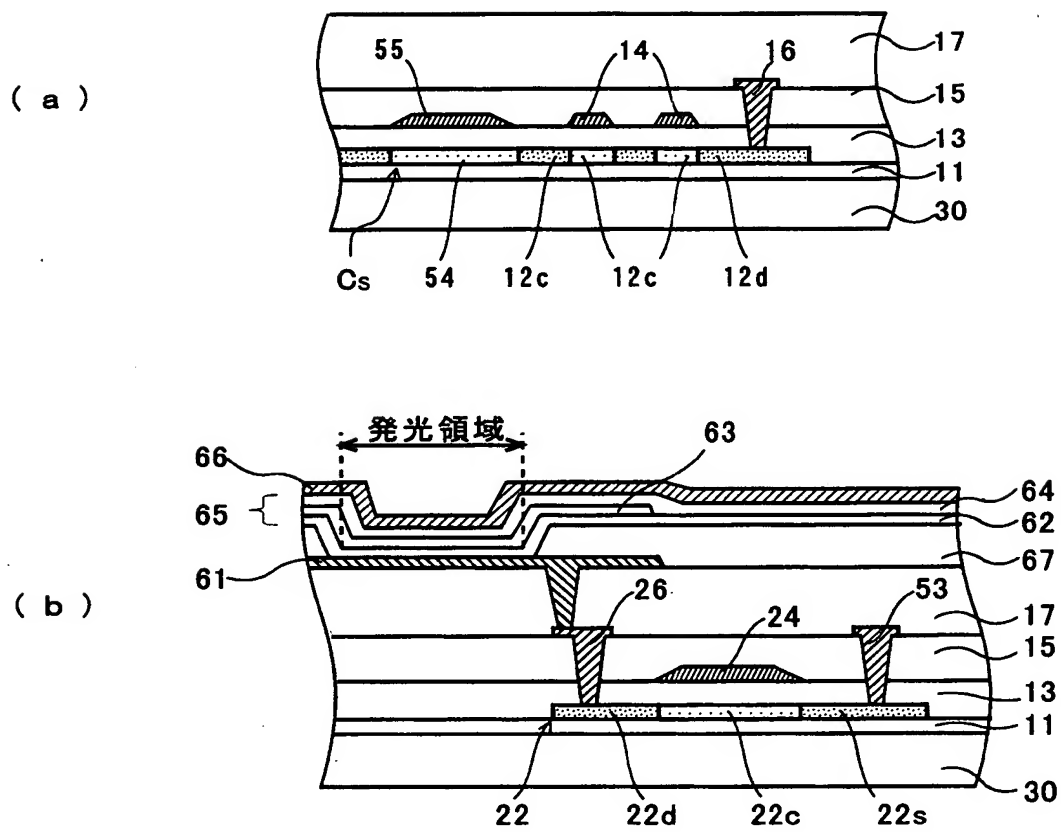




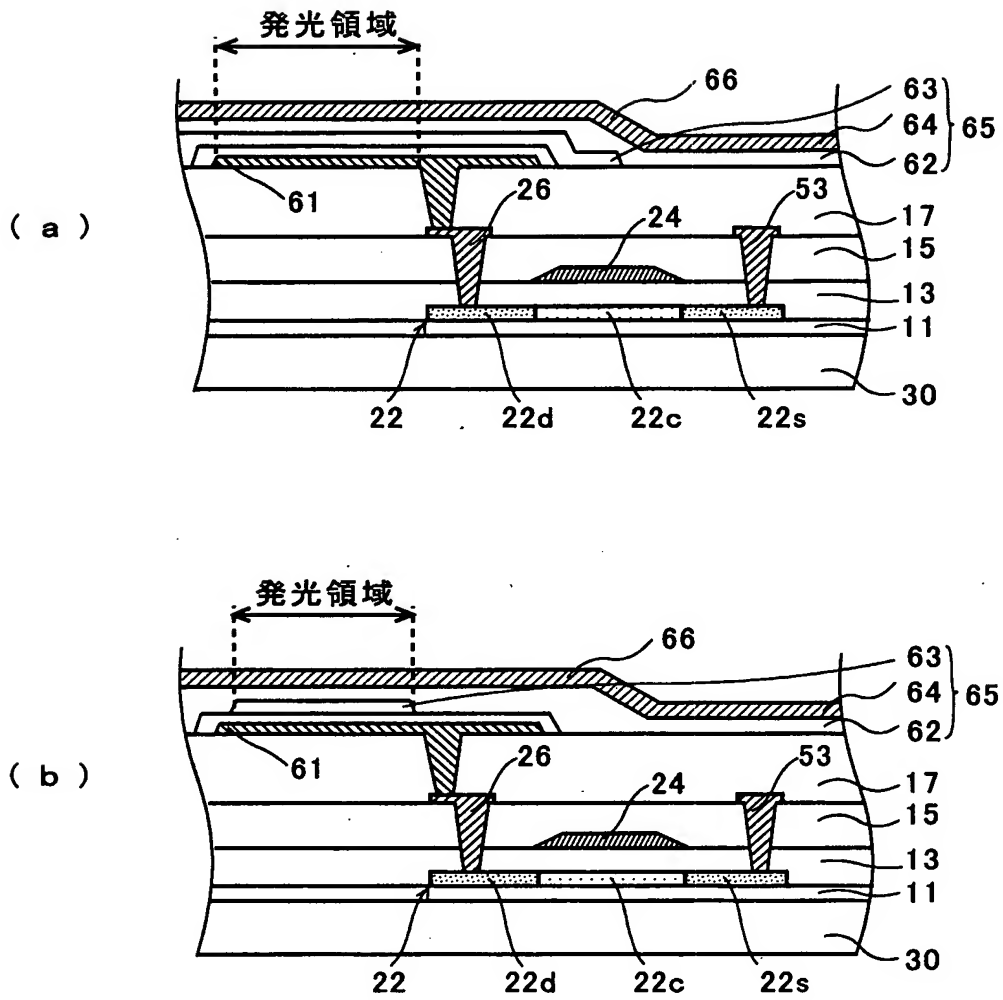
【図 3】



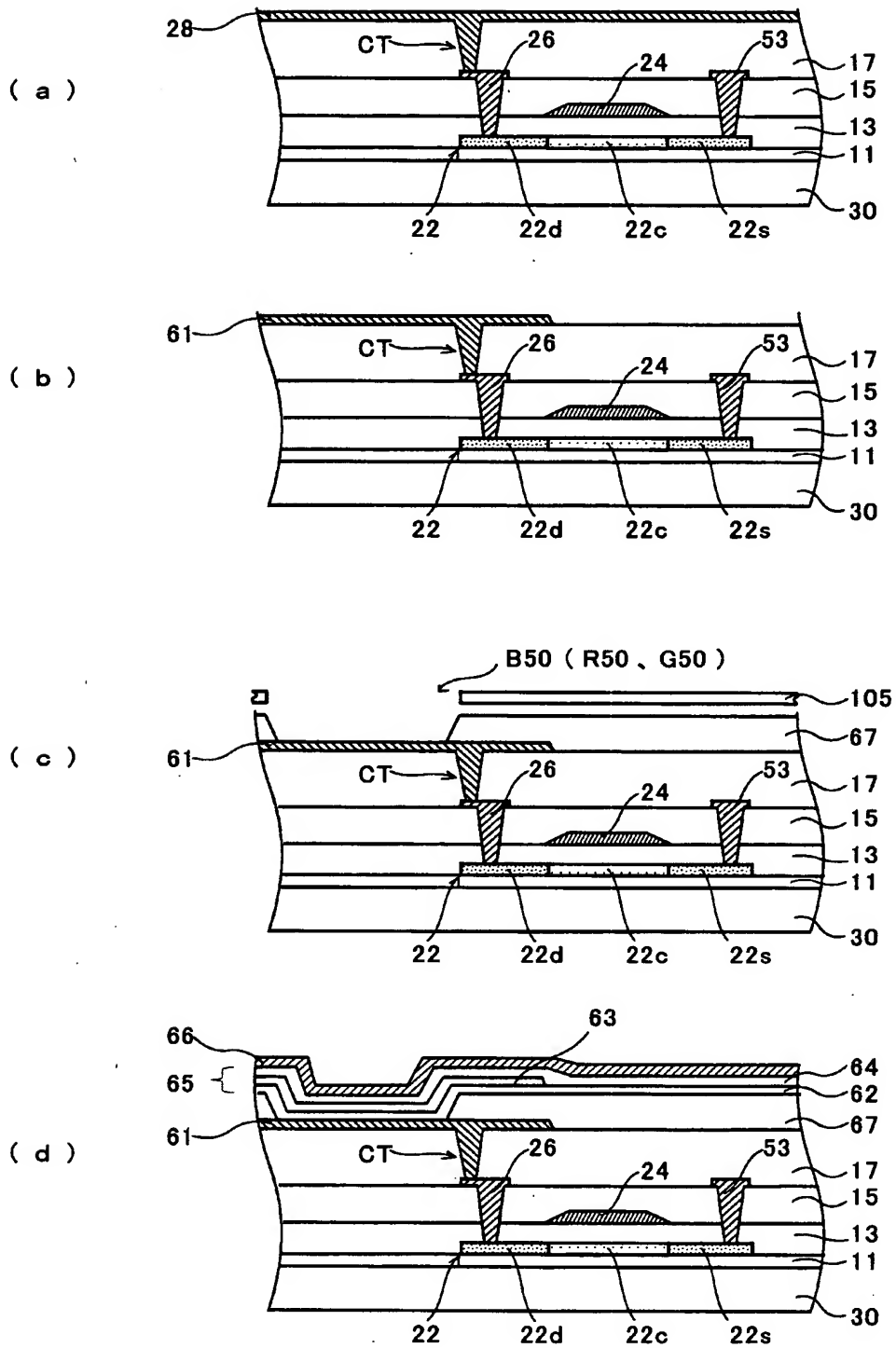
【圖 4】



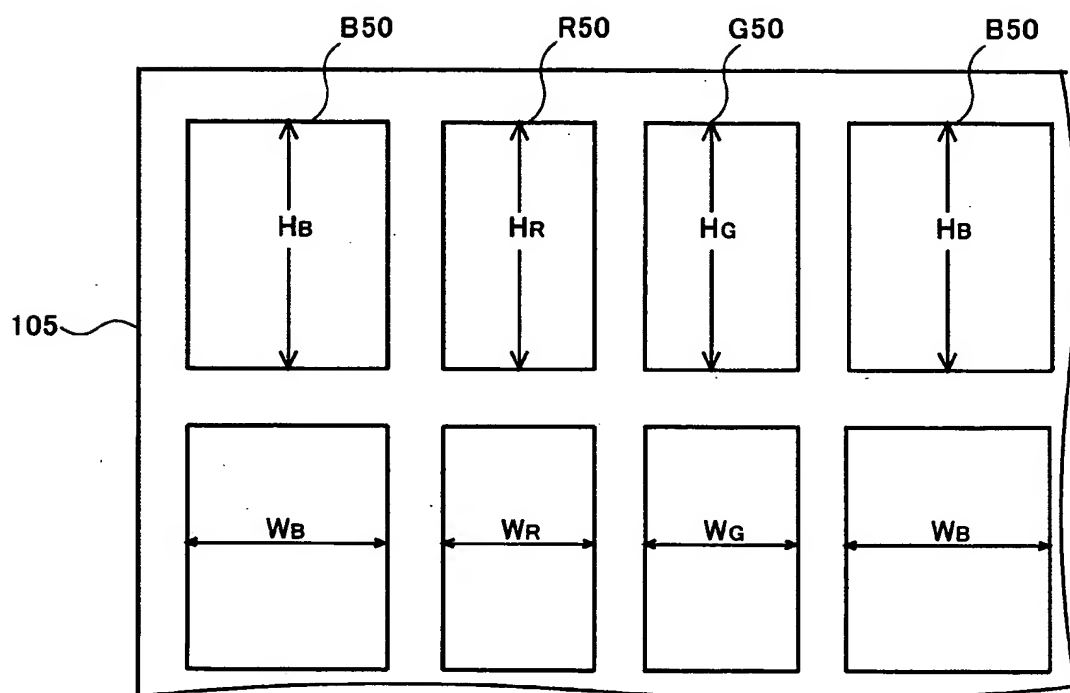
【図 5】



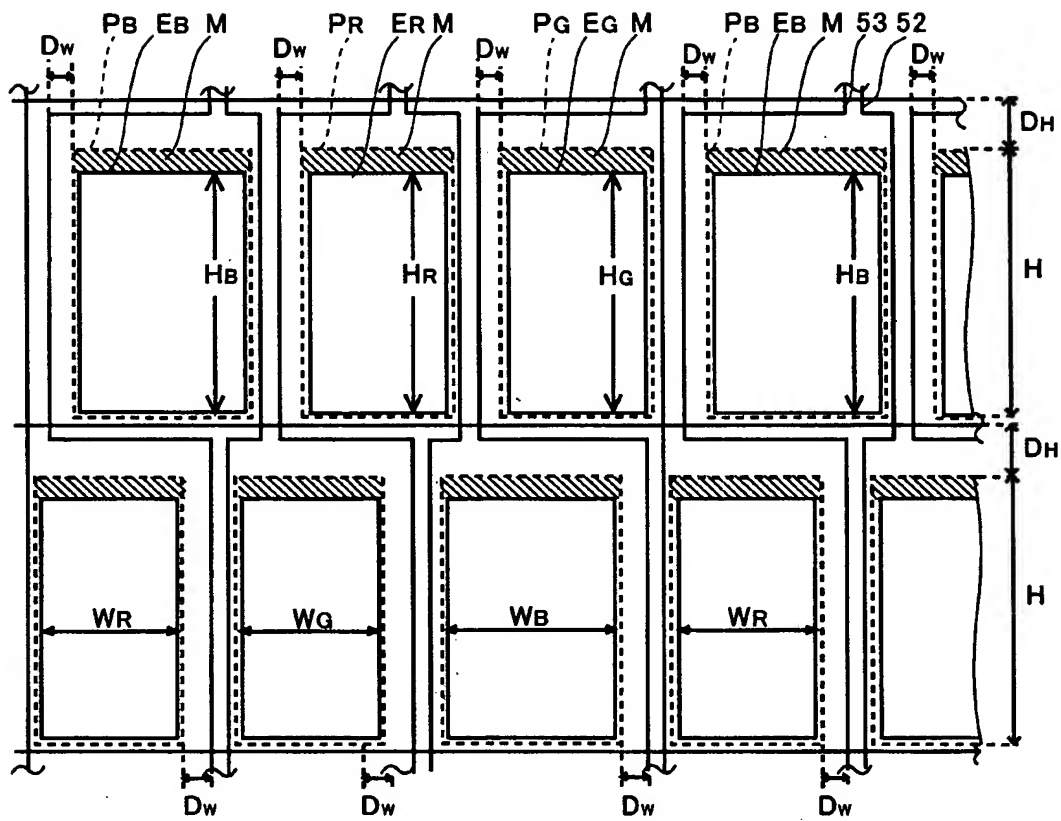
【図 6】



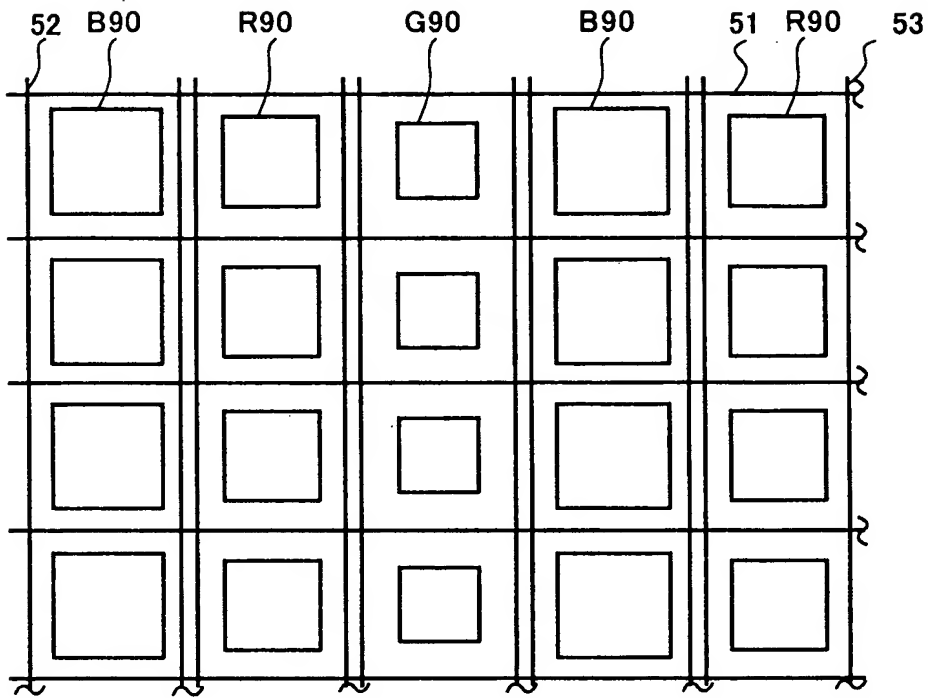
【図 7】



【図 8】



【図 9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】色成分ごとに所望の輝度を得るために寿命の短い発光材料に過大な電流を流すことによる早期劣化を防止するとともに、装置の設計・製造後に、発光材料を変更する場合、大幅な再設計をしなくても対応できる方法を提供する必要があった。

【解決手段】色成分ごとに、発光材料の寿命に応じて画素領域の行方向の長さを設定することによって、材料による寿命の相違を調節する。さらに、設計後の材料変更に対応できるように、画素領域内の行方向または列方向にマージンをあけ、発光領域を形成する。

【選択図】 図 1



出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 1 8 8 9]

1. 変更年月日 1 9 9 3 年 1 0 月 2 0 日

[変更理由] 住所変更

住 所 大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号

氏 名 三洋電機株式会社